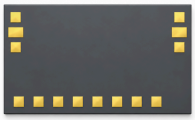
DC–8000 MHz 6ビット GaAs MMIC デジタル・アッテネータ・ベアダイ

LCI-ATT-DC-8000-6B は DC–8000 MHz に対応する6ビット GaAs pHEMT デジタル・アッテネータ・ベアダイで、RF 振幅をステップ調整します。

減衰 RMS 誤差: 0.2 dB (標準値); 挿入損失: 1.6 dB (標準値); 減衰範囲: 0.5 dB (最小値) / 31.5 dB (最大値). ダイ寸法: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.



RF 特性 TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
動作周波数	-	0	-	8000	DC–8000	MHz
挿入損失	-	-	1.6	-	-	dB
減衰範囲	-	0.5	-	31.5	-	dB
減衰 RMS 誤差	-	-	0.2	-	-	dB
減衰による位相変動	-	-	±3	-	-	°
入力 VSWR	-	-	1.3	-	-	-
出力 VSWR	-	-	1.4	-	-	-

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
負電源静止電流	-	-	0.0065	-	-	A
負電源電圧	-	-	-	-	-5	V
入力Highレベル電圧	-	3.3	-	5	-	V
入力Lowレベル電圧	-	-	-	-	0	V
減衰ステップ	-	-	-	-	0.5	dB

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大入力電力	-	-	-	25	dBm

環境仕様

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
保存温度	-	-65	-	150	°C
動作温度	-	-55	-	85	°C

ボンディングパッド配置

ピン番号	記号	機能	備考
1, 3, 4, 6	GND	接地、ワイヤボンディング不要	-
2	RF_in	RF 入力	-
5	RF_out	RF 出力	-
7, 14	VEE	DC バイアス	−5 V
8	A1	減衰制御	0.5 dB; 0 / +3.3 V / +5 V
9	A2	減衰制御	1 dB; 0 / +3.3 V / +5 V
10	A3	減衰制御	2 dB; 0 / +3.3 V / +5 V
11	A4	減衰制御	4 dB; 0 / +3.3 V / +5 V
12	A5	減衰制御	8 dB; 0 / +3.3 V / +5 V
13	A6	減衰制御	16 dB; 0 / +3.3 V / +5 V

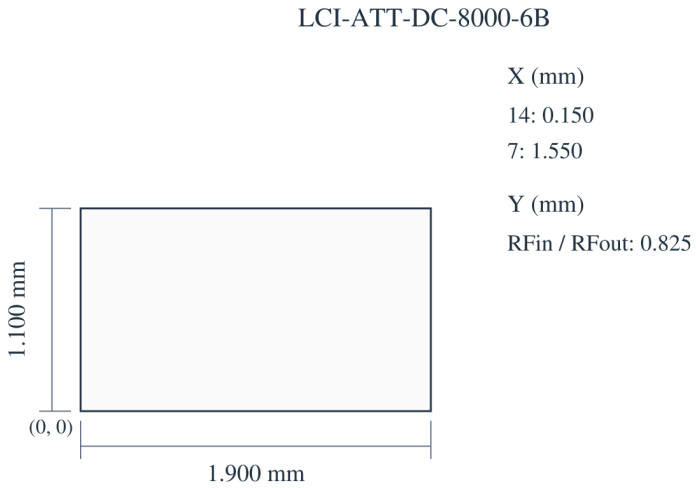
制御真理値表 0 = 0 V; 1 = +3.3–5 V

状態	A6	A5	A4	A3	A2	A1
基準状態	0	0	0	0	0	0
0.5 dB	0	0	0	0	0	1
1 dB	0	0	0	0	1	0
2 dB	0	0	0	1	0	0
4 dB	0	0	1	0	0	0
8 dB	0	1	0	0	0	0
16 dB	1	0	0	0	0	0

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	1.9 × 1.1 × 0.1	mm

一部の寸法を mm で示した参考図です。製造およびワイヤボンディングには詳細図面を参照してください。



1.900 × 1.100 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

ダイ実装とバイアスの印加順序

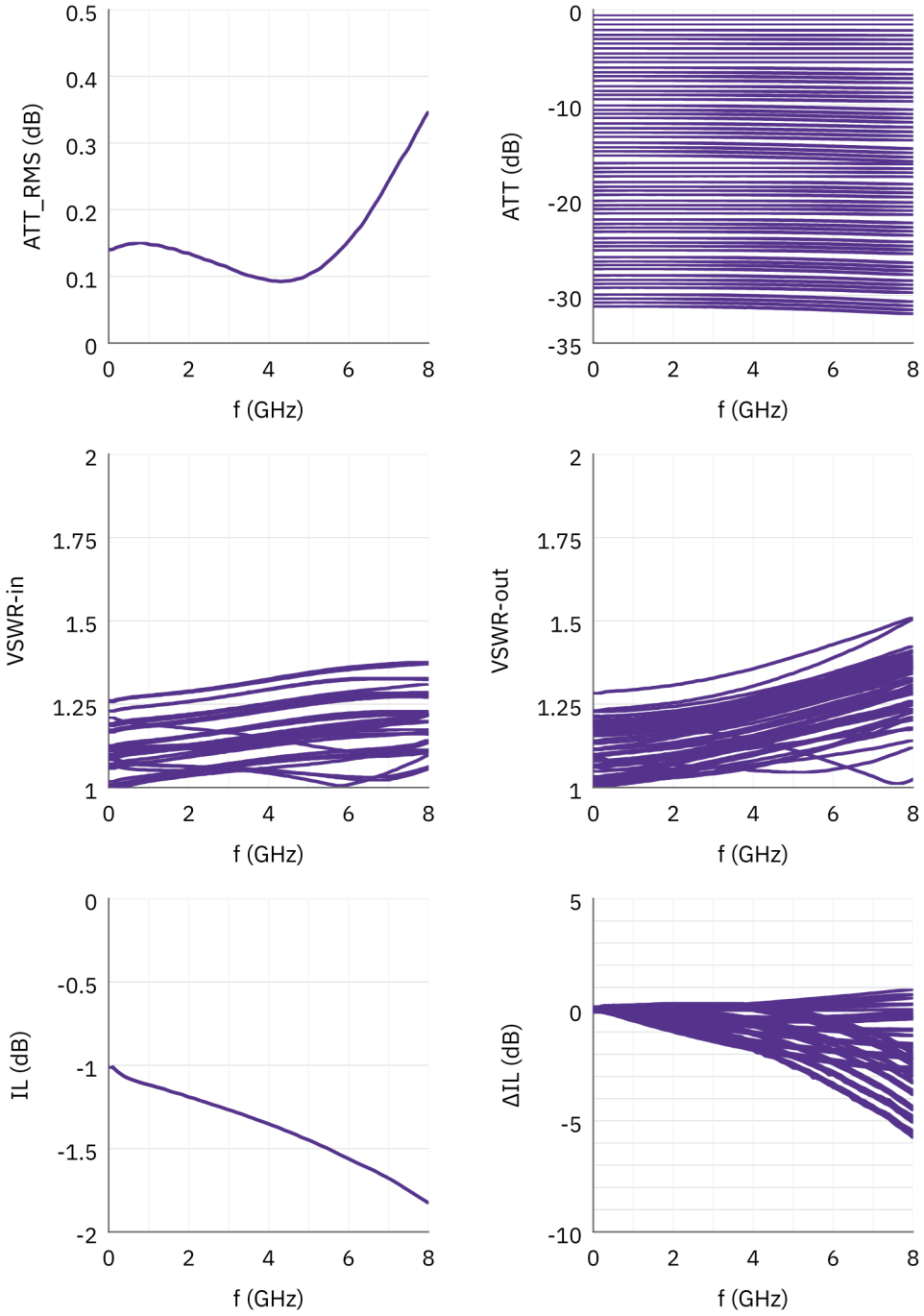
制御インターフェース: パラレル TTL 制御.

性能特性曲線

各図に記載された動作条件と併せてご確認ください。

挿入損失、入力整合、出力整合、減衰量、減衰 RMS 誤差、ΔIL。

読み取り値は近似値です。 最後のグラフは、挿入損失の変動を示す縦軸 delta_IL (dB) に従って読み取ってください。



文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。